


	<h2 style="color: red;">RQ3E120GNTB</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RQ3E120GNTB</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 12A 8-HSMT</p> <hr/> <p>Datenblätter:  RQ3E120GNTB.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 23256 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RQ3E120GNTB
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 12A 8-HSMT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23256 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-HSMT (3.2x3)
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 16W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.8 mOhm @ 12A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	590pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®













































RQ3E120GNTB ist neu im Original, Suche RQ3E120GNTB Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RQ3E120GNTB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RQ3E120GNTB: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>RQ3E120BNTB LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 30V 12A HSMT8</p>	 <p>RQ3E130MN ROHM RQ3E130MN ROHM</p>	 <p>RQ3E130BN ROHM RQ3E130BN ROHM</p>	 <p>RQ3E130MNTB ROHM RQ3E130MNTB ROHM</p>
 <p>RQ3E120ATTB LAPIS Semiconductor MOSFET P-CH 30V 12A HSMT8</p>	 <p>RQ3E120BN QQ2850920316 RQ3E120BN QQ2850920316</p>	 <p>RQ3E130BNTB LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 30V 13A HSMT8</p>	 <p>RQ3E120BNFU7TB ROHM RQ3E120BNFU7TB ROHM</p>

heiße Teile

Mehr

 APL1431LABC-TRL	 CDBC5200-HF	 DS520005	D FOD3184SV	 HCPL-817-06CE
 RQ3E070BN	 RQ3E070BNFU7	D RQ3E070BNFU7TB	 RQ3E070BNTB	 RQ3E080BN
 RQ3E080BNFU7	 RQ3E080BNFU7TB	 RQ3E080BNTB	 RQ3E080GN	 RQ3E080GNTB
D RQ3E100BN	 RQ3E100BNFU7	 RQ3E100BNFU7TB	 RQ3E100BNTB1	 RQ3E100GN
 RQ3E100GNFU7TB	 RQ3E100GNTB	 RQ3E100MN	 RQ3E100MNFU	 RQ3E100MNTB
 RQ3E110AJ	 RQ3E120AT	D RQ3E120AT-TB	 RQ3E120BN	 RQ3E120BNFU7TB
 RQ3E120GN	D RQ3E130BN	 RQ3E130BNFU7TB	 RQ3E130MNTB	 RQ3E130MUTB
 RQ3E13BNFU7	 RQ3E150BN	 RQ3E150BNFU7	 RQ3E150GN	 RQ3E150MN
 RQ3E150MNFU7TB1	 RQ3E150MNTB	 RQ3E160AD	D RQ3E160ADM6	 RQ3E160ADTB1
 RQ3E180BN	 RQ3E180GN	 RQ3G100GN	 RT9161A-12GV	 TQM7M4014

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited